

Hinweise und Schwerpunkte für Kurzkontrollen Physik 9

- Kurzkontrollen werden **nicht** oder nur indirekt **angekündigt!**
- Bereite dich also **ständig** vor – lerne nicht nur einmal, sondern **mehrmals!**
- Nicht nur in den Hefter „**reingucken**“, sondern „**etwas tun**“ (abschreiben, rechnen, abfragen, ...)!
- Verwende beim Lernen die bereits durchgeführten **Übungen** und dein **Tafelwerk!**
- Die **Übungen** findest du auch auf meiner Homepage unter **www.frank-haberecht.de !**
- Berechnungen erfolgen immer mit **ausführlichem Rechenweg** mit **Maßeinheiten!**
- Diese Schwerpunkte sind nur Hinweise – Grundlage für alle Kontrollen ist der **behandelte Stoff!**

KK Mechanik: 4 Bewegungsaufgaben

- **gleichförmige** Bewegung: eine Berechnung: **Geschwindigkeit**
↗ siehe AB „*Berechnungen zur gleichförmigen Bewegung*“
- **beschleunigte** Bewegung: 3 Berechnungen: **Beschleunigung** (geg.: Zeit + Geschwindigkeit)
Zeit (geg.: Beschleunigung + Weg)
Strecke (geg.: Beschl. + Geschw.)
↗ siehe AB „*Berechnungen zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung*“

KK Astronomie: Planeten

- Besonderheiten Planeten: für Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn jeweils eine Besonderheit, die man begründen muss
für Venus, Mars, Jupiter und Saturn jeweils eine Besonderheit, die man nicht begründen muss
↗ siehe AB „*Unsere 8 Planeten*“
- Erde als besonderer Planet: 2 Gründe für die Erde als einziger belebter Planet unseres Sonnensystems
↗ siehe AB „*Unsere 8 Planeten*“
- Unterscheidung Planeten: Einteilung der Planeten in 2 Gruppen mit 2 Unterscheidungskriterien
↗ siehe AB „*Unser Planetensystem*“ (Tabellen-Kopf)
- Gesetze: Kepler'sche Gesetze + Gravitationsgesetz (exakte Wort-Formulierungen)
↗ siehe AB „*Planetenbewegungen*“

KK Elektrizitätslehre: Halbleiter

- Aufbau: speziellen Aufbau von Halbleitern erläutern
(Aufbau eines HL-Atoms, gitterartiger Aufbau von HL, Ladungsträger)
↗ siehe AB „*Aufbau von Halbleitern*“
- Widerstandsverhalten: Widerstands-Veränderung bei Erwärmung/Abkühlung mit Begründung
↗ siehe AB „*Leitfähigkeit von Halbleitern*“
- Herstellung: Herstellung von p-leitenden HL durch Dotieren (Aufbau, Ladungsträger)
↗ siehe AB „*Dotieren von Halbleitern*“
- Diode: Entstehung der Grenzschicht (p-n-Übergang)
Durchlassrichtung: Anschluss der Diode, Erklärung des Leitungsvorgangs
↗ siehe AB „*Aufbau einer HL-Diode*“ + AB „*Funktionsweise HL-Diode*“